

平成 28 年 11 月 15 日

委 員 各 位

日本学術振興会  
ワイドギャップ半導体光・電子デ  
バイス第 162 委員会  
委員長 岸野克巳

日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会  
第 97 回委員総会・第 101 回研究会および特別功績賞贈呈式  
開催案内

下記の通り、12月16日(金)ー17日(土)にホテルサンバレー富士見にて学振162委員会第97回委員総会および第101回研究会を開催致します。初日16日の夕刻には、長年、本162委員会を牽引されてこられました、162委員会前委員長 吉川明彦先生に対する特別功績賞贈呈式および祝賀会を執り行う予定となっております。多くの委員の皆様のご参加を是非宜しくお願い致します。

さて、本委員会の前委員長、吉川 明彦先生は、II-VI族化合物半導体始まり、III-V族窒化物半導体の分野で、長年にわたり研究開発を進め、ワイドギャップ半導体の結晶成長の理解から、物性と評価、さらにはデバイス化に至る広い領域で基礎研究を行い、先駆的な多くの業績をあげてこられました。窒化物半導体分野でみると、GaNの極性制御、In(Ga, Al)N成長評価と制御、InN原子層エピタキシなど、記憶に残る顕著な成果を発表され、ワイドギャップ半導体の学術的理解を大きく進めて、この研究分野で世界を先導して今日に至っております。

また、学振第162委員会においては、その発足当初から今日まで、委員会の活性化のため、粉骨砕身のご活躍をされ、現在の本委員会の成功に大きなご貢献をされて、産学官相互連携の促進および関連分野の産業創出と振興に多大なご功績をあげてこられました。

本委員会としては、このような吉川先生のこれまでのご功績を称え、また本委員会に対するご貢献とご尽力に感謝し、「特別功績賞」を差し上げる運びとなりました。

そこで、今回、12月の委員会・研究会に合わせ、「特別功績賞の贈呈式と祝賀会」を計画し、委員各位および講演者間の親睦をはかる意見交換会とかねて開催いたしますので、万障お繰り合わせのうえ、ご出席いただきたく存じます。

さらに、研究会では、新たな三名の企画主査の皆様が、魅力的なプログラムを策定され、今回が、通常の研究会としては、第一回目の企画となります。

皆様、年末のお忙しい時期ではございますが、本委員会として大変に重要な行事があり、さらに興味深い研究会をアレンジいたしておりますので、ぜひともご出席いただきたく、よろしくお願いたします。

## 記

### 日本学術振興会ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第162委員会 第97回委員総会・第101回研究会 開催案内

日時： 平成28年12月16日(金)～17日(土)

研究会： 16日 15:00 - 17:00

特別功績賞贈呈式・祝賀会： 16日 18:15 - 20:15

研究会： 17日 9:30 - 12:00、13:00-14:30

委員総会： 17日 12:00 - 12:50

場所： ホテルサンバレー富士見

〒410-2201 静岡県伊豆の国市古奈 185-1

(伊豆箱根鉄道「伊豆長岡」駅 徒歩12分)

TEL： 055-947-3100 <http://www.izu3800.jp/hotel/fujimi.html>

#### 特別功績賞贈呈式・祝賀会 12月16日(金)

※前委員長 吉川明彦氏に特別功績賞を贈呈し、意見交換会を兼ねて祝賀会を開催します。

#### 委員総会 12月17日(土)

議題：

- (1) 前回第96回委員総会議事要録承認について
- (2) 委員の異動について
- (3) 次回第102回研究会以降の研究会について
- (4) 平成29年度の研究会計画について
- (5) 国際会議 LEDIA' 17 (2017/4/19～21) への協賛について
- (6) その他

報告事項：

- (1) 開催報告：学振162委員会第100回研究会記念シンポジウム、祝賀会
- (2) その他

研究会 12月16日(金)、17日(土)

主 題：「ワイドギャップ半導体の結晶成長とデバイス技術を俯瞰して ～技術課題と新展開～」

12月16日(金)

「委員長挨拶、企画の趣旨説明」 (15:00 - 15:15)

1. **特別講演**「ワイドギャップ半導体の魅力と“相応しい”エピタキシ評価・制御法の開発・展開  
－窒化物半導体とその動的原子層成長の最近の進展を中心に－」 (15:15 - 16:15)  
吉川 明彦 (千葉大学)
2. 「SiC パワーデバイスの進展と今後の課題」 (16:15 - 17:00)  
木本 恒暢 (京都大学)

**特別功績賞贈呈式・祝賀会および意見交換会** (18:00 - 20:00)

12月17日(土)

3. 「超小型 RGB レーザモジュールの開発と展開」 (9:30 - 10:15)  
中村 孝夫 (住友電気工業株式会社)
4. 「ダイヤモンドデバイスの現状と課題」 (10:15 - 11:00)  
小出 康夫 (物質・材料研究機構)
5. 「AlN 結晶成長の新規手法開発」 (11:15 - 12:00)  
福山 博之 (東北大学)

**委員総会／昼食** (12:00 - 12:50)

6. 「窒化物半導体材料・デバイス開発と微細構造解析」 (13:00 - 13:45)  
富谷 茂隆、田中 伸史、丹下 貴志、蟹谷 裕也 (ソニー株式会社)
7. 「高耐圧パワーデバイスに向けた SiC エピタキシャル成長と欠陥低減」 (13:45 - 14:30)  
土田 秀一 (電力中央研究所)

---

<追記>

1. 12月17日の委員総会ではご出席の回答をいただいた委員・同伴者に昼食をご用意いたします。
2. 12月16日(金)の研究会終了後に意見交換会を行います。宿泊なしにて意見交換会にご出席希望の方は担当幹事の片山先生 (大阪大学) (katayama.ryuji@eei.eng.osaka-u.ac.jp) までお早めにご相談ください。
3. 準備の都合上、委員総会・研究会への出欠回答を **11月25日(金)**までにお願ひします。